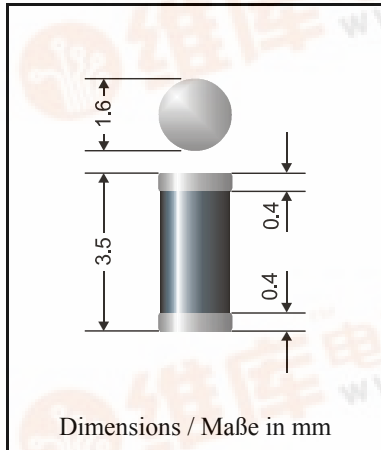


**Surface mount bidirectional
Silicon-Trigger-Diodes (DIAC)**

**Bidirektionale Silizium-Trigger-Dioden
für die Oberflächenmontage (DIAC)**



Breakover voltage	28 ... 45 V
Durchbruchsspannung	
Plastic case MiniMELF	SOD-80
Kunststoffgehäuse MiniMELF	DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0	
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled	see page 18
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	siehe Seite 18

Maximum ratings

Grenzwerte

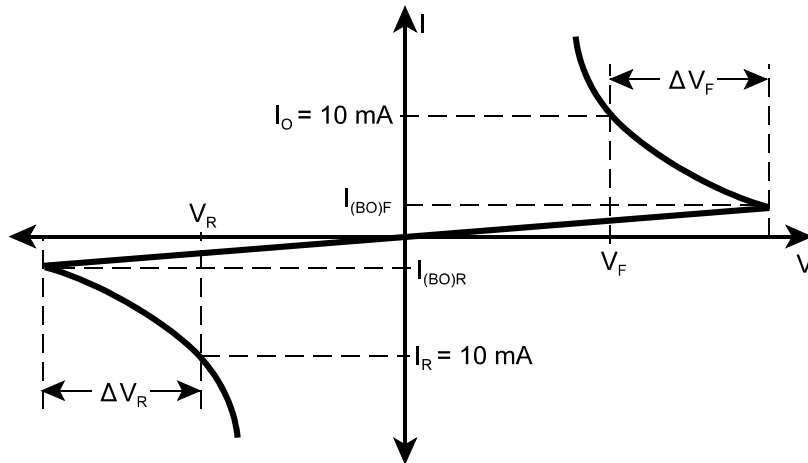
Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	150 mW ¹⁾
Repetitive peak forward current	$t \leq 20\text{ }\mu\text{s}$	I_{FRM}	2 A ¹⁾
Periodischer Spitzenstrom			
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	- 50...+100 $^{\circ}\text{C}$
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	- 50...+150 $^{\circ}\text{C}$

Characteristics

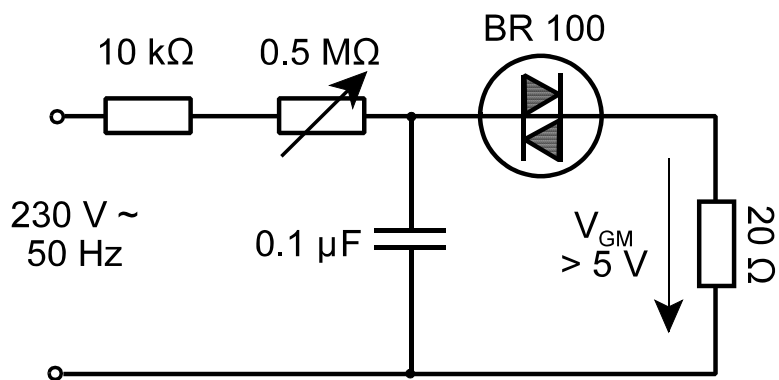
Kennwerte

Breakdown voltage	$dV/dt = 10\text{V}/\mu\text{s}$	BR 100/03 LLD	V_{BO}	28 ... 36 V
Durchbruchsspannung		BR 100/031 LLD	V_{BO}	30 ... 34 V
		BR 100/04 LLD	V_{BO}	35 ... 45 V
Breakdown current – Durchbruchstrom	$V = 98\text{ }\% V_{\text{BO}}$		I_{BO}	< 50 μA
Asymmetry of breakdown voltage	$ V_{(\text{BO})\text{F}} - V_{(\text{BO})\text{R}} $		ΔV_{BO}	< 3.8 V
Unsymmetrie der Durchbruchspannung				
Foldback voltage – Spannungs-Rücksprung	$dV/dt = 10\text{V}/\mu\text{s}$		$\Delta V_{\text{F/R}}$	> 5 V
$\Delta I = I_{\text{BO}}$ to/auf $I_{\text{F}} = 10\text{ mA}$				
Thermal resistance junction to ambient air			R_{thA}	< 300 K/W ¹⁾
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft				

¹⁾ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß



Typical characteristic of a DIAC – Typische DIAC-Kennlinie



Test circuit for a thyristor trigger – Meßschaltung für Thyristor-Zündschaltung